「低次元量子スピン系(無機系・実験)の最近の展開2」

擬一次元スピン・ギャップ系における 不純物誘起反強磁性相

— スピン・パイエルス物質 (S = 1/2)CuGeO₃ と ハルデン物質 (S = 1)PbNi₂V₂O₈—

東京大学大学院新領域創成科学研究科物質系専攻 益田 隆嗣¹、内野倉 國光²

我々は量子スピン系の実験的研究をここ数年来おこなっており、とりわけスピン・ギャッ プを有する系における不純物誘起反強磁性相に着目している。ここでの"不純物誘起反強 磁性相"とはスピン・ギャップと反強磁性の二つの秩序変数が共存した相のことを指して おり、通常の反強磁性相とは異なるものである。この不純物誘起反強磁性相はスピン・パ イエルス物質 CuGeO₃ で初めて見出されたが、スピン・ギャップと反強磁性秩序という 一見相反する二つのパラメータが共存している、という意外性から多くの注目を浴びてき た。この反強磁性相については CuGeO₃ でもっとも詳細に研究されているので、前半で は CuGeO₃ の不純物誘起反強磁性相について詳細に述べる。スピン・パイエルス系以外 でも、ラダー系、ハルデン系など他のスピン・ギャップ系においても、CuGeO₃ 同様の現 象がみられるのではないか、つまり不純物誘起反強磁性相の出現はスピン・ギャップ系に ユニバーサルな現象なのではないか、という観点からハルデン物質 PbNi₂V₂O₈ においても不純物誘起反強磁性相が観測されたので、後半 ではこの物質についての解説を行う。

1 はじめに

低次元量子スピン系の研究は、1930年代のBethe 仮説をはじめとして、非常に古くか ら研究されてきた分野である。これが1983年の Haldane 仮説 [1] および1986年の高温超 伝導発見によって、より広い分野の多くの人々の注目を集めるようになった。この原稿を 書いているのは西暦 2000年であり、随分と年月が経っているが今もなお理論、実験両面 から精力的な研究がなされている。現在もっとも興味をもたれている系の一つとしては、 やはりスピン・ギャップを有する系、すなわち、ハルデン系、スピン・パイエルス系、二 本足梯子系、スピン交替鎖系などが挙げられるであろう。これらの系を体現する現実の物 質は実験家によって数多く見出されており、それらを一々挙げていったらきりが無いほど

¹tmasuda@k.u-tokyo.ac.jp

²uchinokura@k.u-tokyo.ac.jp

である。ごく最近見つけられたものに限っても、たとえば新潟大学での日本物理学会第55 回年次大会概要集を紐解いてみれば、ハルデン系のNDMAP[2]、スピン・パイエルス系 のp-CyDOV[3]、二本足梯子系のSrCu₂O₃[4]、ダイマー系のSrCu₂(BO₃)₂[5]、など、あ と変わったところでは強磁性-反強磁性交替鎖のIPACuCl₃[6] などが目にとまる。いずれ の系も、鎖間相互作用や異方性エネルギー項などを大きくすることで実効的な次元性を上 げることにより基底状態はギャップフルな非磁性状態からギャップレスな非磁性状態、現実 には反強磁性状態へと変化する。実験的にこれらを観測する方法として思い浮かぶのは、 圧力効果、混晶試料の作製などであろう。たとえばハルデン物質に圧力をかけることによ り、鎖間相互作用を変化させて秩序状態を観測できれば興味深いと思われる。現実には圧 力が足りなかったり、構造相転移を起こしてしまったり、などの理由により実現は難しい が、しかしこのような動機からの実験的研究は多く行われている。最近では NDMAP[2] やTlCuCl₃[7] などで磁場印加によりスピン・ギャップをつぶして秩序状態を発現させる研 究も注目を浴びている。

我々はギャップを有する状態とギャップレスな状態の境界付近に位置する物質に注目し ている。我々の最近の研究によって、このような物質において、磁性を担うイオンを非磁 性イオンで置換することにより、つまり一次元鎖にスピン欠陥を導入することにより反強 磁性相が誘起されることが明らかになってきた。この反強磁性相が通常の反強磁性相と 大きく異なるのは、基底状態において反強磁性秩序変数のみならず、スピン・ギャップも 共存していることである。この新奇な不純物誘起反強磁性相の先駆的研究となったのが、 1993年に長谷、寺崎、内野倉によって発見された [8] スピン・パイエルス物質 CuGeO₃[9] の不純物置換効果 [10] である。そこで前半では CuGeO₃ の不純物誘起反強磁性相につい て解説する。同様の現象が二本足梯子系の SrCu₂O₃[4] でも見出され、また 1999 年には PbNi₂V₂O₈[11] の発見により、ハルデン系においても起こることが明らかとなった。これ らにより、不純物誘起反強磁性相の出現は、一般にスピン・ギャップ系にユニバーサルな 現象ではないか、と我々は考えている。後半では PbNi₂V₂O₈ の物性とその不純物置換効 果について解説を行う。

2 スピン・パイエルス物質 CuGeO3 と不純物誘起反強磁性相

スピン・パイエルス物質 CuGeO₃ は 1993 年の発見以来 7 年もの年月が過ぎたが、それ にもかかわらず現在なお精力的に研究が続けられている。この物質の発見が量子スピン系 の実験家にとって幸いであったことは、CuGeO₃ が無機物質であること、また多くの高温 超伝導体と異なり組成が単純でかつ調和溶融型の物質であることであった。前者の理由に より、すでに多く報告されてきた有機物質においては非常に困難であった [12] 不純物置 換効果が容易となった [10]。また後者の理由により、大型で良質な単結晶作製が容易とな り、中性子非弾性散乱による磁気分散関係の研究が可能となった。これについては、西ら によってはじめて行われ、スピン・パイエルスエネルギー・ギャップが観測されたが、同 時に鎖間相互作用が一次元鎖内相互作用の1/10と、擬一次元系としては大きいことが分かった[13]。このことが、典型的な(有機)スピン・パイエルス物質とは大きく異なる点であり、後に述べる不純物誘起反強磁性相出現という、新しい物理現象を我々に教えてくれるところとなった。

 $CuGeO_3$ の不純物効果は長谷らによって初めて試みられ、不純物量増加に伴い、スピン・ パイエルス転移温度 (T_{SP}) は単調に減少し、高濃度においては転移が観測されなくなるこ とが見出された [10]。さらにスピン・パイエルス転移が観測される低濃度置換試料におい ては、 T_{SP} 以下の低温で新しい秩序相が存在することが $Cu_{1-x}Zn_xGeO_3$ において観測され た。後にこの相は反強磁性相であることが判明し [14, 15, 16]、現在では $Cu_{1-x}M_xGeO_3(M$ = Zn[10, 14, 15, 16, 17]、Ni[14, 17, 18, 19]、 Mn[14]) および CuGe_{1-y}Si_yO_3[20] におい て低温で不純物誘起反強磁性長距離秩序相が出現することが知られている。

この現象の新しくまた興味深い点は、反強磁性長距離秩序と、スピン・パイエルス転移 にともなう格子の dimerization の長距離秩序とが共存していることにある。このことは反 強磁性相の発現する同じ試料において、高磁場で磁性相 (M 相あるいは不整合相 (IC 相) と呼ばれる)が出現するという実験事実 [21, 22] からも分かるように、反強磁性長距離秩 序とスピン・パイエルスギャップが共存する状態であり、今まで知られたことのない全く 新しい状態であることは、筆者達には、少なくとも実験的には自明の事柄であると思えた のであるが、そのような考えは必ずしも当然のこととして直ちに受け入れられたわけでは ない。反強磁性相は三次元性を、スピン・パイエルス相は一次元性を反映した現象であり、 これら二つの秩序変数を同時に持つ一つの状態が存在しうるということを直感的に受け入 れることは難しいかったようである。そのため、当初は反強磁性転移温度 (T_N) 以下におい ては格子の dimerization は存在していないか、仮に存在していたとしても不純物分布の不 均一性のために反強磁性相とスピン・パイエルス相とが相分離しているのではないか、と 主張する研究者もいた。しかし、スピン・パイエルス秩序変数と反強磁性秩序変数の共存 の可能性は CuGe_{1-v}Si_vO₃[23]、Cu_{1-x}Zn_xGeO₃[24, 25]、Cu_{1-x}Ni_xGeO₃[26]の中性子回 折実験によって裏付けられた。図1は、dimerizationの格子歪みの大きさを反映する、超 格子ピーク強度と、反強磁性ブラッグピークの温度依存性を測定したものである [25]。超 格子ピークは、磁気ブラッグピークが立ち上がるT_N(4.1 K)以下で減少するものの、有限 に残っていることが分かる。この実験結果、すなわち二つの秩序変数の共存した状態は、 福山、谷本、斎藤らが、位相ハミルトニアンの方法を用いることにより絶対零度において 理論的にその存在を示唆した[27]。不純物サイトにおいては dimerization による格子歪み が抑制されると仮定し、これを境界条件として、格子変位 (u_l) とスピンの z 成分 $(\langle S_l^z \rangle)$ を 求めた。その結果、

$$u_l = (-1)^l u(x), u(x) = u_0 k \operatorname{sn}[(x + x_{\text{imp}})/\xi]$$
(1)

$$\langle S_l^z \rangle = (-1)^l S(x), S(x) = s_0 dn[(x + x_{imp})/\xi]$$
 (2)

となった。ここで uo は不純物を入れていない場合のスピン・パイエルス状態における





図 1: dimerization による超格子ピーク と反強磁性磁気ブラッグピークの温度依 存性。文献 [25] より。

図 2: 福山らにより提唱された、不純物置 換 CuGeO₃ の T = 0 K における dimerization の大きさ (上図) とスピン (下図) の空間分布。文献 [27] より。

dimerization の大きさ、 ξ はスピン・パイエルス系のソリトン励起の幅、 s_0 は量子揺らぎ による磁気モーメントの減少を表す因子である。図2が式(1),(2)をプロットしたもので 各々の包絡線はJacobiの楕円関数となっている。不純物は $l = 0 \ge l = 70$ にあるとしてい る。不純物近傍ではスピンが大きく生き返り dimerization が抑制されているのに対し、不 純物から離れるに従いスピンは抑制され dimerization は復活している様子が分かる。また $u_l \ge S^z \ge$ はともに (-1)^lの周期は保っており、すなわち dimerization と staggerd moment とが長距離相関をもって共存していることが分かる。彼らのモデルは、Cu_{1-x}Zn_xGeO₃ お よび CuGe_{1-y}Si_yO₃の μ SR の実験結果 [28] とも矛盾しないことが現在では分かっている。

以上見てきたように、CuGeO₃はスピン・パイエルス系を実験的研究する上で、不純物 添加と結晶作製が容易であり有利であるというだけでなく、"不純物誘起反強磁性相"を 持つ、という興味深い物質であることが分かる。CuGeO₃が一次元スピン系としてはいわ ば劣等生であり、比較的大きな鎖間相互作用を持っているわけだが、そのためにほとんど 予想されていなかったような、全く新しい物理現象の存在を我々に教えてくれるところと なった。この物質は、帯磁率曲線がBonner-Fisher 曲線でフィット出来ないこと、典型的 スピン・パイエルス物質では観測されるはずのソフトフォノンが観測されていないこと、 圧力下での転移温度とエネルギーギャップなどの関係が典型的スピン・パイエルス系の理 論である Cross-Fisher の関係式と矛盾すること、などなど、スピン・パイエルス物質とし ての劣等生ぶりもなかなかのものである。解明されつつあるものもあるが、まだまだこれ から新しい物理現象につながるような事実もある。そこで、本節では我々が重点的に研究 してきた不純物誘起反強磁性相について現在までに知られていることをレビューする。

2.1 $Cu_{1-x}Zn_xGeO_3$ の極めて不純物濃度の薄い領域における反強磁性相

反強磁性長距離秩序と dimerization の共存する状態は、果たしてどの程度低濃度の不純 物まで存在するのであろうか。この状態が存在する臨界温度が存在するのか、あるいは純 粋な CuGeO₃(もっとも、意図して不純物を添加しなくても欠陥は存在するであろうから、 純粋か否かという判定も難しいが) でも低温になれば反強磁性秩序を持つのであろうか。 このような観点から、Cu_{1-x}Zn_xGeO₃の $x \to 0$ 、従って極低温での振る舞いが間部らに よって行われた [29]。

試料は floating zone (FZ) 法により作製した。不純物濃度は誘導結合高周波プラズマ発 光分析 (ICP-AES) を用いた。試料の冷却には³He-⁴He 希釈冷凍機 (最低温度 20 mK) 及 び核断熱消磁冷却装置 (最低温度 10 mK 以下) を組み合わせた装置が用いられた。

図3はCu_{1-x}Zn_xGeO₃($x < 5 \times 10^{-3}$)の様々な不純物濃度試料の交流帯磁率測定の結 果である。磁場は磁化容易軸方向であるc軸に印加している。いずれの試料についても14 K 近傍でスピン・パイエルス転移による帯磁率の落ち込みが観測され、またより低温で はZn 置換により生じたスピン (S = 1/2)によるキュリー項が観測されている。このキュ リー項から不純物量を見積もったところ、ICP-AESによる組成分析の結果と誤差20%程 度で一致した。さらに低温で、全ての不純物置換試料において反強磁性転移が観測されて いる。純粋試料についても格子欠陥や微量な不純物により生じたスピンによるキュリー項 が観測されている。この結果から純粋試料における実効的な不純物濃度を見積もったとこ $S_x = 2.3(2) \times 10^{-4}$ であった。12 mK 近傍で帯磁率の飽和が観測されているが、これに は二つの可能性が考えられる。一つには、試料が実際には12 mK までは冷えていないこ とが考えられる。もう一つは、実際に帯磁率は12 mK で飽和していることが考えられる。 この場合12 mK より低温で反強磁性転移が存在していることが示唆される。確実に言え る事は、12 mK 以上では反強磁性転移は存在しないことである。

図4はスピン・パイエルス転移温度 (T_{SP}) と反強磁性転移温度 (T_N) を不純物濃度 x に対してプロットした組成-温度 (T - x) 相図である [29]。不純物量増加に伴う T_{SP} の減少と、 T_N の増加して行く様子がみられる。微量な不純物濃度 $x = 1.12(2) \times 10^{-3}$ の試料で反強磁性転移が $T_N = 0.0285$ K においても反強磁性相転移がはっきりと観測されている (図3参照)。低濃度領域で

$$T_{\rm N} = A \exp[-B/x] \tag{3}$$

という実験式を使って表すことが可能であった。図中の実線は、A = 2.3 K、 $B = 5.7 \times 10^{-3}$ ととった場合の (3) 式を表していて、低濃度領域では良い近似であることが分かる。また 実効的な不純物濃度が $x = 2.3(2) \times 10^{-4}$ である純粋試料において、12 mK 以上において は T_N が観測されていないこととも矛盾しない。以上より、CuGeO₃ においてはごく微量 の非磁性不純物で Cu を置換することにより不純物誘起反強磁性相が出現し、式 (3) の依





図 3: $Cu_{1-x}Zn_xGeO_3$ ($x < 5 \times 10^{-3}$)の交流帯 磁率測定。磁場は磁化容易軸のc方向に印加。文 献 [29] より。

図 4: Cu_{1-x}Zn_xGeO₃の組成-温 度相図。文献 [29] より。

存性が示すように、この現象には臨界濃度は存在しないことが分かった。

2.2 不純物誘起反強磁性相における一次相転移

低濃度領域における反強磁性相については、今まで述べたようなスピン・パイエルスの 格子歪みを伴った新しいタイプの反強磁性相であることが分かった。ところが、T - x 相図 の高濃度領域においては、問題が残っていた。 $Cu_{1-x}Zn_xGeO_3$ の笹子ら [24]、Martin ら [25] による中性子回折実験によれば $x \sim 0.04$ 程度まで dimerization による超格子ピーク が観測されているのに対し、帯磁率測定ではスピン・パイエルス転移に伴う落ち込みがよ り低濃度で観測されなくなる。 $CuGe_{1-y}Si_yO_3$ については帯磁率測定によるT - x 相図だ けに注目してみても、日本のグループとヨーロッパのグループとで大きな食い違いがあっ た。最近益田らが $Cu_{1-x}Mg_xGeO_3$ についてスピン・パイエルス相が消失していく様子に 注目し、比較的高濃度までの詳細なT - x 相図の研究を行った結果、不純物誘起反強磁性 相には高濃度側と低濃度側とで異なる二つの相が存在し、それらの相間には一次相転移が 存在することが明らかになった [30]。またこれにより、中性子回折と帯磁率測定との間の 食い違いについても一応の解決をみた。そこで本節では $Cu_{1-x}M_xGeO_3$ の反強磁性相に おける組成的一次相転移について述べよう。

従来 CuGeO₃ の置換効果では非磁性不純物としては Zn を用いることが多かった。初期 の段階で Mg を用いたこともあったが焼結体を作製したところ Mg が均一に分布しないこ とが判明したため、しばらくは用いなかった。しかし FZ 法によって単結晶作製を行うと、 事情が異なることが明らかになり、Mg を不純物とする研究が復活し、その結果ここに述 べるような現象が見出されることになった [30]。

図5は、Cu_{1-x}Mg_xGeO₃とCu_{1-x}Zn_xGeO₃の単結晶のスケッチと ICP-AES 法による



図 5: 単結晶試料の ICP-AES による組成分析結果。文献 [31] より。

組成分析の結果である [31]。 $Cu_{1-x}Mg_xGeO_3$ の方が $Cu_{1-x}Zn_xGeO_3$ よりも濃度の誤差が 少なく高品質の不純物置換試料が作製可能であることが分かる。また濃度が飽和するまで に必要な結晶の長さも短くてすむので結晶作製が $Cu_{1-x}Zn_xGeO_3$ よりも容易であること もわかる。これらより、詳細なT - x相図の研究や、特に大きな結晶を必要とする中性子散 乱実験では $Cu_{1-x}Mg_xGeO_3$ が必要不可欠になるわけである。また、 $Cu_{1-x}Mg_xGeO_3$ の 場合、 $x \sim 0.12$ 程度の高濃度試料が作製可能であることも分かっている。

Cu_{0.959}Mg_{0.041}GeO₃の低温での帯磁率の磁場に対する異方性を測定したところ、Mg で Cu を置換した場合も、Zn の場合と同様 c 軸方向を磁化容易軸とするように反強磁性相が 低温で発現することが分かった。図 6(a) に磁場を c 方向にかけた場合の 2 K < T < 20 K における帯磁率 ($\chi_c(T)$)を、また図 6(b)~(e) では T_N 近傍での $\chi_c(T)$ を示す [30]。図 6(a) から、 $x \le 0.023$ については高温側でスピン・パイエルス転移による帯磁率の落ち込みが 観測されているが、x > 0.023 の試料では観測されていないことが分かる。低温側に注目 すると、図 6(b)~(e) から x = 0.023 以外の試料については T_N でのピークは鋭いのに対し て、x = 0.023 の試料についてのみブロードになっている。転移温度 T_{SP} , T_N は、転移前 後でのデータを直線でフィットし、その交点で決定している。ただし、x = 0.023のデー タについては、ピークがブロードになっているために図 6(c) の実線のような 3 本の直線の 交点から二つの転移温度 T_{N1} , T_{N2} を定義した。

これら多くの不純物濃度試料に対する帯磁率測定より定めた T_{SP} 、 T_N を不純物濃度に対してプロットした温度-組成(T - x)相図が図7(a)である。不純物濃度の増加に伴い、 T_N



より。



 Go for the state of the state of



図 7: (a)Cu_{1-x}Mg_xGeO₃ の温度-組成相 図。文献 [30] より。(b),(c) D-AF, U-AF 相のスピンの空間分布 (概念図)。

が徐々に高くなっていくが、 $x \sim 0.023$ において 3.4 K から 4.0 K へ急激な増加が観測される。そこでこの濃度を以下では x_c と定義する。 $x_c < x \lesssim 0.04$ では T_N はプラトーを持ち $x \gtrsim 0.04$ では T_N はプラトーを持ちったが、1.9 K (我々の用いた SQUID 磁束計の低温側限界) 以上では反強磁性転移は観測されなかった。 T_{SP} については不純物増加に伴い単調に減少し、 $x \sim x_c$ で $T_{SP} \sim 10$ K 程度に達する。 $x > x_c$ においては帯磁率測定においてはスピン・パイエルス転移は観測されない。

図 7(a) において、 $x = x_c$ において T_N の跳びとも思われるような急激な増加が観測され ていることから、CuGeO₃の不純物誘起反強磁性相は $x < x_c$ と $x > x_c$ とで本質的に異なる 相に属しており、これら二相間には組成的な一次相転移が存在することが予想される。さら に $x_c < x$ でスピン・パイエルス転移が観測されないことから dimerization は存在せず、格 子は uniform であることが予想される。実際、文献 [30] の時点で行われていた $x \sim 0.04$ の 試料での中性子回折実験 [32] では 1.3 K まで dimerization による超格子ピークは観測され なかった。またこの高濃度側の相は、古典的な反強磁性相、すなわち Cu²⁺ イオン上のスピ



図 8: (a)Cu_{1-x}Mg_xGeO₃の x_c 近傍試料の T_N 付近における帯磁率。0.0237 $\lesssim x \lesssim 0.0271$ に おいてダブルピークが観測されている。左上の挿入図は $\partial(\chi_{\parallel}T)/\partial T$ で、二つのピークか ら T_N を決定した。下側挿入図は広い温度域の帯磁率で x = 0.0288の試料においては SP 転移による帯磁率の落ち込みは観測されていない。(b) x_c 近傍の詳しい温度-組成相図。文 献 [31] より。

ンのスタッガード磁化は空間的な不均一は存在せず、uniform であることが予想される (図 7(c))。以上から高濃度側の反強磁性相を U-AF (uniform-antiferromagnetic) 相と定義した。 また x = 0.017 について中性子回折では、CuGe_{1-y}Si_yO₃[20] や Cu_{1-x}Zn_xGeO₃[24, 25] の 低濃度試料と同様、超格子ピークが観測された。したがって、低濃度側はスピン・パイエル ス秩序変数と反強磁性長距離秩序変数を同時に持っている一つの相 (図 7(b)) であること が予想され、これを D-AF (dimerized-antiferromagnetic) 相と定義した。つまり、CuGeO₃ の不純物誘起反強磁性相はこれら二つの本質的に異なる相からなり、二つの相間には一次 相転移が存在することが分かった。

この組成的一次相転移の存在は、さらに詳細な帯磁率測定 [31]、中性子回折 [32, 33, 34, 35]、シンクロトロンX線回折 [36, 31, 37]、熱伝導率測定 [38] によっても研究され、その存在が支持されている。臨界濃度試料における T_N の急激な変化を調べるため、 x_c 近傍試料の T_N 付近の帯磁率測定を、温度間隔を 0.025 K として詳細に行った (図 8(a))[31]。x = 0.0237, 0.0248, 0.0254, 0.0271 の試料においては明確にダブルピークが観測されているのに対し、x = 0.0229, 0.0288 の試料についてはピークは一つしか観測されていない。また広い温度域での帯磁率を示した下側挿入図から、 $x \le 0.0271$ においては 10 K 近傍でカスプが存在するのに対し、x = 0.0288 においては存在しない。このことからスピン・パイエルス転移は $x \le 0.0271$ においては存在し、 $x \ge 0.0288$ で消失することが分かる。以下で、ダブルピークが観測され始める濃度を x_{c1} 、再びシングルピークが観測され、スピン・パイエルス転移が消失する濃度を x_{c2} と定義する。我々は $x_{c1} = 0.0237, x_{c2} = 0.0271$ 得た。これら二つを特に区別する必要の無い場合は今までどおり単に x_c と表記する。 T_{SP}



図 10: (a) x = 0.032の試料における (3/2, k, 3/2)の超格子ピーク。白丸は測定分解能を示すために載せた (3, 2k, 3)のブラッグピーク。超格子ピークの線幅は明らかに分解能よ

の格子ひずみの自乗。文献 [34] より。

の決定については以前と同様、転移前後でのデータを直線フィットし、その交点を転移温 度とし、 T_{N1} についてはFisherの方法 [39] に従い、 $\partial(\chi_{\parallel}T)/\partial T$ の極大となる温度を用い た。二つの極大がある 0.0237 $\leq x \leq 0.0271$ の試料については、低温側を T_{N1} 、高温側を T_{N2} と定義した (図 8(a)の左上挿入図)。ピークが一つのものについては従来のように T_N と定 義する。このようにして得られたT - x相図を図 8(b)に示した。文献 [30] では組成的相 転移が一次的であることの根拠が、x = 0.023の試料で T_N のピークがブロードであった ことと SP 相の消失であった。詳細な帯磁率測定の結果、このブロードなピークは実はダ ブルピークであり、 $x < x_{c1}$ における T_N は $x = x_{c1}$ において T_{N1} と、また、 $x > x_{c2}$ にお ける T_N は $x = x_{c2}$ において T_{N2} と滑らかに接続することが分かる。従って T_{N1} 、 T_{N2} は それぞれ D-AF、U-AF 相への転移温度であることが分かる。このことから $x_{c1} \leq x \leq x_{c2}$ の 試料において D-AF,U-AF 相の相分離がおこっていることが示唆される。これらの結果は 組成的相転移が一次的であることを強く支持するものである。またダブルピークを示す試 料が、濃度の誤差 0.1%(図 5)以上に広い範囲に存在している。これは、一般に一次相転移 に見られる過冷却のような準安定状態によるものと思われる。

り広がっている。(b) Cu_{1-x}Mg_xGeO₃ の有効磁気モーメントの自乗。(c) Cu_{1-x}Mg_xGeO₃

スピン・パイエルス転移による帯磁率のカスプは、スピン・パイエルスギャップによるも のであり、これまでに主張してきた $x > x_c$ においてスピン・パイエルス相の消失、とは正 確にはスピン・パイエルスギャップの消失のことである。x > xc における格子系の様子を 調べるために中性子回折実験が中尾らにより行われた [33, 34]。図 9(上図) は (3/2, 1, 3/2) の超格子ピークの温度依存性である。スピン・パイエルス転移に伴う格子の dimerization により、たとえばx=0の試料では14K以下で超格子ピークが立ち上がっていく様子が観 測されている。また置換試料においては低温で反強磁性転移が生じるとともにピーク強度 が抑制されていることが分かる。帯磁率測定からは x > x_{c2} ~ 0.027 ではスピン・パイエ ルスギャップは確認されなかったが、中性子回折から臨界濃度以上の x = 0.028,0.032の試 料においても dimerization が存在することが明らかになった。しかし、x = 0.032の超格 子ピークプロファイルを示した図 10(a) から分かるように、ピークの線幅は分解能より広 がっていることが分かる。このことは dimerization の相関が短距離であることを意味して いる。図9(下図)に示すようにペアの組み方によって dimerization には二種類の位相(π異 なる)(α, β) を持つことが可能であるが、CuGeO₃の純粋試料においては相関長は無限大、 すなわちどちらか片方の位相のみが実現していると考えられる。一方 x > x_cの試料にお いてはスピン・パイエルスギャップが消失するとともに、格子系においては dimerization は α, β の二つの位相が混在し、短距離秩序のみが存在すると考えてよいことが分かった。 図 9(上図) において x < x_c の試料 (x = 0.017,0.026) では超格子ピーク強度が最低温で有 限にとどまっているのに対し、 $x > x_c$ の試料 (x = 0.028, 0.032) においてはゼロに向かっ ていることが分かる。このことは絶対零度においては、*x > xc* で短距離秩序も含め格子歪 みは消失していることを示唆している。図 10(b),(c) は磁気ブラッグピーク及び格子の超 格子ピークの強度から見積もった有効磁気モーメント (µeff)の自乗及び格子歪みの大きさ (δ_{eff}) の自乗の濃度依存性である。 $\mu_{\text{eff}}^2(x), \, \delta_{\text{eff}}^2(x) / \delta_{\text{eff}}^2(0)$ ともに x_c で急激に変化してい ることが分かる。この傾向は低温でより顕著である。図 10(c) から磁化測定により提案さ れた D-AF、U-AF 間の組成的相転移の存在が支持される。また図 10(b) から D-AF 相で は強い量子揺らぎのためにスピンの大きさは抑制されているのに対し、U-AF 相において は古典的な反強磁性状態に近く、xcの付近でスピンのモーメントは大きく復活しているこ とが分かる。

中性子回折によって $x > x_c$ において格子の dimerization は急激に抑制され、かつその 相関は短距離であることが分かった。そこで $x \sim x_c$ における dimerization の相関を調べ るため、分解能の優れた X 線回折を Cu_{1-x} Mg_x GeO₃ に対して行った [31]。図 11 の挿入図 は x = 0.021, 0.026 の試料における (1.5, 1, 1.5) の longitudinal scan のピークプロファイ ルである。x = 0.021 の線幅は X 線の分解能以下であったが、x = 0.026 の線幅は明らか に広がっていることが分かる。図 11 は 4 K におけるピークプロファイルに deconvolution を施して見積もった dimerization の逆相関長である。斜線の領域は帯磁率で反強磁性転移 のダブルピークが観測された領域で左端が x_{c1} 、右端が x_{c2} に対応している。 $x \leq x_{c1}$ では dimerization は長距離秩序であり、 $x \sim x_{c1}$ で相関は有限になり $x > x_{c2}$ で急激に短くなっ





図 11: Cu_{1-x}Mg_xGeO₃の逆相関長。挿 入図は x = 0.021, 0.026の試料における (1.5, 1, 1.5)の longitudinal scanのピー クプロファイル。文献 [31] より。

図 12: Cu_{0.983}Mg_{0.017}GeO₃ 試料の longitudinal scan \mathcal{O} (a) 線幅及び (b) ピーク強 度の温度依存性。(a) において deconvolution はほどこされていない。文献 [36] より。

ていくことが分かる。このことから格子系においても磁気系で観測された組成的な相境界 が存在することが明確となった。図12はx=0.017の試料の線幅及びピーク強度の温度依 存性である [36]。ピーク強度は 9.0 K あたりから立ち上がっているのに対し、線幅は 9.0 K ではまだ装置分解能に達していない。温度低下とともに徐々に長くなり、装置分解能に達 するのは8.0 K 以下であることが分かる。そこで、X 線回折で逆相関長が装置分解能に達 した温度で dimerization の相関が長距離になったとみなし、この温度を T'_{SP} と定義した。 装置分解能は逆数をとれば 5000 Å 程度であり、不純物間距離より充分長いので、T'_{SP} で dimerization が長距離秩序であると考えるのは妥当であろう。ピーク強度の立ち上がる温 度は 9.0 K だが、X 線回折は装置分解能がきわめて高いので積分強度にすれば立ち上がり の温度はずっと高温側にシフトするはずである。実際、図9(b)から、中性子回折のピーク 強度は 11 K 程度から立ち上がっている。中性子回折の装置分解能は 0.002 Å^{−1} 程度と、X 線回折より広いのでピーク強度が事実上の積分強度となっているわけである。dimerization がはじまる温度と、その相関が長距離になる温度との間には大きな隔たりがあることが分 かる。そこで以下では $T < T'_{SP}$ をスピン・パイエルス長距離秩序相 (SP-LRO)、 $T'_{SP} < T < T$ $T_{\rm SP}$ をスピン・パイエルス短距離秩序相 (SP-SRO) とよぶことにする。帯磁率、中性子回 折の超格子ピーク強度から求めた $T_{
m SP}$ 、X線回折による $T'_{
m SP}$ および帯磁率による $T_{
m N}$ を全 てプロットしたT - x相図を図 13 に示す。 T'_{SP} が T_{SP} よりずっと低温であるのに対し、中 性子回折のピーク強度と、帯磁率から決めた TSP はほぼ一致している。中性子回折では装 置分解能から、超格子ピークが観測可能になるためには dimerization の相関長が 500 Å 程





図 13: Cu_{1-x}Mg_xGeO₃ の温度-組成相 図。文献 [31] より。

図 14: Cu_{1-x}Zn_xGeO₃の反強磁性転移 温度付近での帯磁率。挿入図は温度-組成 相図。文献 [41] より。

度になることが必要である。実験結果は、相関長が無限大に発散していなくてもスピン・ パイエルスギャップが開き、帯磁率の測定でも検出できることを示唆している。CuGeO3 の純粋試料と異なり Cu_{1-x} M_x GeO3 の場合スピンの一次元鎖は不純物サイトで分断され ている。 $T_{SP} > T > T'_{SP}$ においては dimerization の位相は不純物サイトでピン止めされて いると考えられる。このような現象は Cu_{1-x}(Zn, Ni)_xGeO3 の高磁場における非整合相に おける不純物と磁気的ソリトンの間においても観測されている [40]。低温になると鎖間相 互作用とスピン・格子相互作用とによって domain となって分断されている dimerization の位相が徐々にそろっていき、 T'_{SP} において長距離秩序相が実現していると考えられる。 そして、系の磁気的性質を反映する帯磁率から提案された $x \sim x_c$ における組成的相境界 は、格子系においては dimerization の長距離秩序相の消失する境界に対応していることが 分かった。

ここまでで Cu_{1-x} Mg_x GeO₃ において組成的一次相転移が存在することを述べてきたが、 この現象が不純物置換 CuGeO₃の系に一般にみられるものなのかどうか、興味あるところ である。そこで我々は Cu_{1-x} Zn_x GeO₃ についても帯磁率測定を行い、T - x 相図を作成した (図 14)[41]。幅広い濃度領域での相図はすでに多く報告されているので、スピン・パイエル ス相が消失する濃度付近の試料について詳細な測定を行った。x = 0.017, 0.019, 0.023の試 料については反強磁性転移温度でダブルピークが観測されているのに対し x = 0.016, 0.025の試料についてはシングルピークのみが観測されている。これは Cu_{1-x} Mg_x GeO₃ の場合 と全く同様であり、挿入図に示した T - x 相図も定性的には同じである。ダブルピーク構 造が Mg 置換試料の場合に比べてあいまいなのは図 5 に示したように不純物分布の均一性 が比較的悪いためであると考えられる。以上より Mg 置換試料に見られた組成的一次相転 Bussei Kenkyu

特集

移は非磁性不純物置換した場合に生じる一般的な現象であることが分かる。

3 新しいハルデン物質 PbNi₂V₂O₈と不純物誘起反強磁性相

以上で見てきたようにS = 1/2のスピン・ギャップ状態を持つ無機スピンパイエルス物 質 CuGeO₃ は不純物誘起反強磁性相を持ち、全く新しい物理現象であることが明らかに なりつつある。ここで問題にするのは、これらの現象はS = 1/2のスピン・ギャップ状態 を持つ物質に特有な現象か否かということである。

他の代表的な低次元スピン・ギャップ状態の一つにいわゆるハルデン状態がある [1]。ハ ルデン状態とは一次元鎖上に等間隔に並んだS = 1(もっと一般的に言えばS = 整数)の スピンが反強磁性相互作用をしている系で見られる現象である。スピン (i 番目のスピンを S_i と表そう)間の相互作用が

$$\mathcal{H}_{\text{in-chain}} = J \sum_{i} S_{i} \cdot S_{i+1}, \quad J > 0,$$
(4)

と書かれる時に、基底状態は唯一で非磁性の一重項状態 (合成スピン $S \equiv \sum_i S_i$ がS = 0の状態) であり、一番低い励起状態は三重項状態 (S = 1) で磁性を持つが、基底状態と三重 項状態の間にエネルギーギャップがあるため、低温になると磁性を次第に失う。CuGeO₃ で現れるスピン・ギャップ状態は、温度を下げていった時に結晶格子が関与した相転移が 起こり、スピン間の距離に alternation が起こるため生じるのに対し、ハルデンギャップ状 態は結晶格子の変化を伴うことなしに、スピン・ギャップ状態が生じる。このような違い があるにもかかわらず、スピン・ギャップが生じるという点では共通性を持っている。従っ てハルデン系においても鎖間相互作用が比較的大きな物質については CuGeO₃ 同様不純 物誘起反強磁性相が生じるのではないか、というのがこの研究の出発点であった。

3.1 PbNi₂V₂O₈の性質

ハルデン物質はすでにいくつか存在していることが報告され、また不純物効果の報告も ある。しかしながら不純物によって反強磁性相が誘起されたという報告はなかった。した がってこの研究をはじめるに当たってまず新しい(しかも不純物誘起反強磁性相が起こる 可能性のある) ハルデン物質を見つけなければならなかった。第一に候補にのぼったのは $SrNi_2V_2O_8$ である。構造は後で説明するが、ここで主役を演じる可能性があるのはもち ろん Ni^{2+} イオンであって、スピンはS = 1 である。この物質は結果的には6 K以上では ハルデン物質としての特徴を示すものの6 K付近に秩序相への転移を示し、基底状態はハ ルデン状態ではないことが明らかになった [42]。このことは $SrNi_2V_2O_8$ ではスピン鎖の間 の交換相互作用が強く、低温では秩序相が生じてしまっていると考えることができる。し たがって、もしも同じ構造でもっと鎖間の相互作用が小さい物質が見つかれば、その基底 状態はハルデン状態である可能性がある。また同時にそのような物質はたとえハルデン物 質になったとしても、従来知られている物質に比べ鎖間の交換相互作用が強いであろうか

- 482 -

「低次元量子スピン系(無機系・実験)の最近の展開2」



図 15: PbNi₂V₂O₈の帯磁率の温度依存 性。文献 [11]。



図 16: PbNi₂V₂O₈の磁化-磁場特性。文 献 [11]。

ら、我々が探そうとしている"ハルデン物質における不純物誘起反強磁性相"(もしもそん な現象が存在するとすればの話だが)を見つける可能性があると考えられた。

以上のような可能性をもつ物質として合成されたのが PbNi₂V₂O₈ である。この物質に 関しては、わずかにその存在を指摘するごく簡単な報告があるのみで、構造も同定されて おらず、物質としても新物質といってよい。固相反応によって合成された PbNi₂V₂O₈ は SrNi₂V₂O₈の結晶構造 [43] と同型で空間群は正方晶の I41cd であることが明らかになっ た [11]。さらに格子定数は a = 12.249(3) Å, c = 8.354(2) Å であって、SrNi₂V₂O₈ の a = 12.1617 Å, c = 8.1617 Å[43] よりも大きい。従って鎖間相互作用は弱いであろうとい う希望を与えてくれるものであった。結晶構造は図 15 の挿入図に示されているが、Ni²⁺ イオンは単純な直線鎖を形成するのではなく、螺旋を描いている。Ni 螺旋鎖間には非磁性 の VO₄ と Sr²⁺ とが介在し、螺旋鎖間の相互作用が小さくなるようにしているとも、ある いは鎖間相互作用を左右しているとも言える。1 つの Ni²⁺ イオン鎖は、単位胞の中に螺 旋の4つの段を持ち、また単位胞を右巻きと、左巻き螺旋鎖が各々2個、計4個貫いてい る。このため、隣り合う螺旋鎖間で最近接の Ni²⁺ イオン間の距離は、直線鎖と考えたと きの鎖間の距離よりも近い。また一つの Ni²⁺ イオンから見た隣接する螺旋鎖中の最近接 の Ni²⁺ イオンの数 z は (4 個でなく)2 個であって、c 軸方向に c/4 だけ高さが異なってい て、またその距離は約 5.0 Å である (螺旋鎖内の最近接 Ni-Ni 間の距離は約 2.8 Å)。これ らの特徴ある構造が、PbNi₂V₂O₈ あるいは SrNi₂V₂O₈ の物性を大きく左右しているもの と思われる。

図 15 に示したのが PbNi₂V₂O₈ の帯磁率の温度依存性である [11]。ほぼ等方的であって、 低次元スピン系に特有な緩やかな山を持ち、低温になると、意図されない不純物による小 さな寄与を除いてスピン帯磁率は0に向かって減少している。これはまさに、基底状態が 非磁性の一重項でスピン・ギャップを持つ系であることを示唆している。さらに図 16 に は磁化の磁場依存性を示した [11]。磁場が小さい場合には、基底状態がスピン一重項であ ることを反映して磁化は小さな値を示すが、ある値 H_cを越えると磁化の変化が大きくな

る。これは励起状態である三重項状態が基底状態と交差して、磁性を示す新しい基底状態 が実現するためで、スピン・ギャップを有する系の特徴的な振舞である。ここには示さな いが [11, 44] 中性子非弾性散乱によりスピン・ギャップが観測されたことをあわせて、我々 は PbNi₂V₂O₈ がハルデン物質であることを結論した [11]。

次の問題である不純物誘起反強磁性相を述べる前に、純粋な PbNi₂V₂O₈のハルデン状 態をもう少し検討しよう。という意味は CuGeO₃ では、b 軸方向の鎖間の交換相互作用 (反 強磁性的) が鎖内の交換相互作用 (当然反強磁性的)の 1/10 程度あり [13]、このことが不 純物誘起反強磁性相の発現と密接に関係していると考えられ、また PbNi₂V₂O₈ と同じ結 晶構造をしている SrNi₂V₂O₈ の基底状態が秩序状態であることは、PbNi₂V₂O₈ もまた鎖 間の交換相互作用が決して小さくない可能性を示唆しているからである。さてこの問題を 考えるには、相互作用をもっと真面目に検討しなければならない。まず鎖内だけの相互作 用として (4) を考えるのはもちろんであるが、各 Ni²⁺ イオンのスピンは $S_i = 1 > 1/2$ な のでその他に 1 イオン異方性として

$$\mathcal{H}_{\text{single-ion}} = D \sum_{i} (S_i^z)^2, \tag{5}$$

を考慮しなければならないであろう。ここで *z* 方向は *c* 軸に平行である。鎖間の交換相互 作用としては、スピン・ギャップの異方性を的確に表すように、以下のように異方的な交 換相互作用を採用しよう。

$$\mathcal{H}_{\text{inter-chain}} = J \sum_{i,i',k,k'} [J_{1,\parallel} S_{i,k}^z S_{i',k'}^z + J_{1,\perp} \{ S_{i,k}^x S_{i',k'}^x + S_{i,k}^y S_{i',k'}^y \}].$$
(6)

実験は単結晶試料が得られないため、粉末試料で行われ、したがってスピン励起の分散関係 をそのまま求めることはできない。実験では波数 Qの絶対値 Qの関数としての散乱強度が 得られるだけである。従って解析は相互作用 (4)-(6) 式を使って、chain-mean-field-RPA[45] 近似で実験にもっともよく合うパラメタを決定するという方法で行われた。実はほとんど 同じ仮定にもとづく数値計算が坂井-高橋 [46] よって既に行われており、この近似における 相図が求まっている。中性子散乱で得られた鎖間相互作用と1イオン異方性を坂井-高橋の 相図の上に他の代表的なハルデン物質の値とともに描くと、図17のようになる [44]。ここ で SrNi₂V₂O₈ および PbNi₂V₂O₈ の鎖間相互作用は実は強磁性的 ($J_1 < 0$) である。しか し前に書いたように鎖間の近接 Ni²⁺ イオン間の位置は c/4 ずれているので、同一平面上 の Ni²⁺ イオン間の実効的な相互作用は反強磁性的となる。そのため図 17 の縦軸は絶対値 をとり $|zJ_1/J|$ となっている。このようにすると坂井-高橋の相図と対応しうることを注意 しておこう。PbNi₂V₂O₈ も SrNi₂V₂O₈ もともに D < 0の領域 (c 軸を容易軸とする反強 磁性的な性質を持つ領域)にあり、容易軸 (この場合 c 軸) 形反強磁性相とハルデン相 (図 17 では spin-liquid 相と書かれている)の境界付近にあり、SrNi₂V₂O₈ は丁度境界上³に位

³これは技術上の仮定に依存し、実際には僅かに反強磁性相の側に位置しているはずである。このことを図 17 では太線で表している。また $SrNi_2V_2O_8$ が D-M 相互作用の存在のため弱強磁性を示していることは [42] に書いたとおりである。



図 17: $|zJ_1/J| \ge D/J$ の関係。実 線は坂井-高橋 [46] による数値計算。 PbNi₂V₂O₈ と SrNi₂V₂O₈ は [44]、 CsNiCl₃ は [47]、Y₂BaNiO₅ は [48]、 NENP は [49]、AgVP₂S₆ は [50] から。 文献 [44] より。



図 18: Pb(Ni_{1-x}Mg_x)₂V₂O₈ (0 $\leq x \leq$ 0.120) 粉末試料の帯磁率の温度変化。挿 入図は Pb(Ni_{0.970}Mg_{0.030})₂V₂O₈ 配向試 料の帯磁率。文献 [11] より。

置し、一方 PbNi₂V₂O₈ はハルデン相の側に位置していることが明らかになった。いずれ にしても PbNi₂V₂O₈ はスピン・ギャップ状態であるが、反強磁性相に近い鎖間相互作用 を持っているという意味で、CuGeO₃ と似た状況になっていることがわかった。したがっ て、不純物誘起反強磁性相が発現する可能性が現実の問題になってきたわけである⁴。

3.2 PbNi₂V₂O₈の不純物誘起反強磁性相

 Mg^{2+} イオンは非磁性つまり S = 0 である。 Mg^{2+} イオンは Ni²⁺ イオンに置換できる ので、Pb(Ni_{1-x}Mg_x)₂V₂O₈ の結晶を作ると、Ni²⁺ イオン (S = 1) で形成される (螺旋) 鎖は分断され、有限鎖の集まりになる。理想的な一次元鎖の場合有限鎖の両端の付近に S = 1/2の現れることは理論的にも [51, 52] 実験的にも [53] よく知られている。このことは Pb(Ni_{1-x}Mg_x)₂V₂O₈ で低濃度の場合に低温で帯磁率に Curie 項が現れることでも確かめ られる (図 18 の x = 0.010 のデータを見よ)。ところが図 18 で x = 0.20 以上の濃度では帯 磁率が低温で上昇するだけでなく、カスプを持ちそれ以下の温度では逆に減少することが明 瞭に示された [11]。これは明らかに、何らかの秩序状態への転移である。相転移が確かに起 こっていることは、他の測定方法からも明らかである。図 19 に Pb(Ni_{0.970}Mg_{0.030})₂V₂O₈ の比熱の測定結果を示す [54]。相転移に起因する比熱の異常が明らかに観測されている。 次にこの相転移がどのような相転移であるかを調べよう。そのためには帯磁率の異方性を 調べる必要があるが、試料が粉末であるため容易ではない。そのため 9 T の磁場中で粉末 試料を樹脂で固めるという方法を用いて、c軸に配向した試料を作製し、帯磁率の異方性

⁴現実には、これほどはっきりと純粋の PbNi₂V₂O₈ の性質が分かってから、不純物誘起反強磁性相が見つかったわけではなく、むしろ不純物誘起反強磁性相の発見の方が先行していた。





図 19: Pb(Ni_{0.970}Mg_{0.030})₂V₂O₈の比熱 測定。文献 [54] より。

図 20: Pb(Ni_{1-x}Mg_x)₂V₂O₈のT_N-x関係。文献 [54] より。

を調べた。その結果を示したのが、図 18 の挿入図である。 $H \parallel c$ の場合は帯磁率は転移 温度から低温側では0に向かって減少し (完全に0ではないが配向試料であることを考慮 すると単結晶ではおそらく0に向かうであろうと想像される)、また $H \perp c$ ではほぼ一定 である。この振舞いは典型的な容易軸形 (この場合容易軸は c 軸)の反強磁性相転移の性質 であり、この相転移は反強磁性相への相転移であると結論した [11]。前にものべたように ハルデン状態に不純物により反強磁性相が誘起されることが観測されたのは、これが初め てである。

転移温度 (T_N) の Mg 濃度依存性を描いたのが図 20 である。非常にわずかの Mg 濃度で T_N は急激に立ち上がり約 8% で最大値約 3.5 K をとって、さらに濃度が増大すると、 T_N は減少する。この振舞いも CuGeO₃ の不純物誘起反強磁性相の振舞いと共通の点がある ことに注意されたい。

さてこのように、ハルデン物質である PbNi₂V₂O₈ で初めて不純物誘起反強磁性相が見 出された。この現象は低次元スピン・ギャップ系に不純物置換によって反強磁性相が生ず るという意味で、S = 1/2のスピン・パイエルス系 CuGeO₃、あるいはやはりS = 1/2の 2本足スピン梯子系 (2-leg spin ladder)SrCu₂O₃ [4] と共通の性質を示している。SrCu₂O₃ の ladder 間の相互作用の強さに関しては詳しい研究がないようなので、ここではこの物 質を除外して、CuGeO₃ と PbNi₂V₂O₈ を比較しよう。前にも書いたように CuGeO₃ では 鎖間の交換相互作用 (b 軸方向が強い) は鎖内の交換相互作用に比べ約 1/10 であり [13] 二 次元性がかなり強い。また PbNi₂V₂O₈ も鎖間の相互作用がかなり強く、ハルデン相と反 強磁性相の境界付近のハルデン相側に位置していることを示した。このように低次元のス ピン・ギャップ系で鎖間の相互作用の強い場合はスピンの大きさが S = 1/2 であろうと S = 1の系であろうと、不純物誘起反強磁性相が生じる可能性があるというのが我々の結 論である。

4 まとめ

本稿では CuGeO₃ と PbNi₂V₂O₈ のスピン欠陥による不純物誘起反強磁性相についての 解説をおこなった。CuGeO₃ については詳細な研究がなされており、不純物誘起反強磁性 相の発現に低濃度側に臨界濃度は存在しないこと、また比較的高濃度側で組成的一次相転 移が存在することについて詳細な説明を行った。PbNi₂V₂O₈ についてはまだまだ残され ている問題は多く、単結晶作製をはじめ多くの実験的研究を続行中である。

現在までにこれらスピン・パイエルス系、ハルデン系以外にも二本足梯子系のSrCu₂O₃ において同様の現象が観測されている。スピン・ギャップ系には他にもダイマー系、スピ ン交替鎖系などがあるがこれらの系においても不純物誘起反強磁性相が存在する可能性が あり、今後の研究の発展を待ちたい。

謝辞

ここに述べた研究の内で筆者達が関係した研究は、数多くの研究者の方々との共同研究 に基づいています。またその中で中性子散乱の研究は日米科学協力事業「中性子散乱」を 通して行われました。共同研究者の方々に感謝いたします。

参考文献

- [1] F. D. M. Haldane, Phys. Lett. A 93 (1983), 464; Phys. Rev. Lett. 50 (1983), 1153.
- [2] Z. Honda, K. Katsumata, M. Hagiwara and M. Tokunaga, Phys. Rev. Lett. 60 (1999), 9272.
- [3] K. Mukai, N. Wada, J. B. Jamali, N. Achiwa, Y. Narumi, K. Kindo, T. Kobayashi, K. Amaya, Chem. Phys. Lett. 257 (1996), 538.
- [4] M. Azuma, Y. Fujishiro, M. Takano, M. Nohara and H. Takagi, Phys. Rev. B 55 (1997), R8658.
- [5] H. Kageyama, K. Yoshimura, R. Stern, N. V. Mushnikov, K. Onizuka, M. Kato, K. Kosuge, C. P. Slichter, T. Goto and Y. Ueda, Phys. Rev. Lett. 82 (1999), 3168.
- [6] H. Manaka, I. Yamada and K. Yamaguchi, J. Phys. Soc. Jpn. 66 (1997), 564.
- [7] A. Oosawa, M. Ishii and H. Tanaka, J. Phys. : Condens. Matter 11 (1999), 265.
- [8] M. Hase, I. Terasaki and K. Uchinokura, Phys. Rev. Lett. 70 (1993), 3651.
- [9] CuGeO₃ における dimerization の形は少し複雑であったため、dimerization は容易 には観測されず、一時は本当にスピン・パイエルス転移か否か疑問が持たれたようで

あるが、一年余たって廣田達により中性子回折により転移温度以下での原子変位が求められ、最終的にスピン・パイエルス転移であることが確認された。K. Hirota, D. E. Cox, J. E. Lorenzo, G. Shirane, J. M. Tranquada, M. Hase, K. Uchinokura, H. Kojima, Y. Shibuya and I. Tanaka, Phys. Rev. Lett. **73** (1994), 736.

- [10] M. Hase, I. Terasaki, Y. Sasago, K. Uchinokura and H. Obara, Phys. Rev. Lett. 71 (1993), 4059.
- [11] Y. Uchiyama, Y. Sasago, I. Tsukada, K. Uchinokura, A. Zheludev, T. Hayashi, N. Miura and P. Böni, Phys. Rev. Lett. 83 (1999), 632.
- [12] 数少ない有機スピン・パイエルス物質の不純物効果の例としては向井らによる *p*-CyDOV が挙げられる [3]。
- [13] M. Nishi, O. Fujita and A. Akimitsu, Phys. Rev. B 50 (1994), 6508.
- [14] S. B. Oseroff, S. W. Cheong, B. Aktas, M. F. Hundley, Z. Fisk and L. W. Rupp, Jr., Phys. Rev. Lett. 74 (1995), 1450.
- [15] M. Hase, N. Koide, K. Manabe, Y. Sasago, K. Uchinokura and A. Sawa, Physica B 215 (1995), 164.
- [16] M. Hase, K. Uchinokura, R. J. Birgeneau, K. Hirota and G. Shirane, J. Phys. Soc. Jpn. 65 (1996), 1392.
- [17] J-G Lussier, S. M. Coad, D. F. McMorrow and D. McK Paul, J. Phys: Condens. Matt. 7 (1995), L325.
- [18] N. Koide, Y. Sasago, T. Masuda and K. Uchinokura, Czech. J. Phys. 46(S2) (1996), 1981.
- [19] N. Koide, Y. Uchiyama, H. Hayashi, T. Masuda, Y. Sasago, K. Uchinokura, K. Manabe and H. Ishimoto, cond-mat/9805095.
- [20] L. P. Regnault, J. P. Renard, G. Dhalenne and A. Revcolevschi, Europhys. Lett. 32 (1995), 579.
- [21] M. Hase, I. Terasaki, K. Uchinokura and M. Tokunaga, N. Miura and H. Obara, Phys. Rev. B 48 (1993), 9616.
- [22] M. Hase, I. Terasaki, Y. Sasago, K. Uchinokura, M. Tokunaga, N. Miura, G. Kido, T. Hamamoto and H. Obara, Physica B 201 (1994), 167.
- [23] 論文 [20] の著者たちは実験事実の解釈にあたって、T_N 以下の状態を、スピン・パイ エルス相と反強磁性相の相分離した状態の可能性が高いと考えたようである。

- [24] Y. Sasago, N. Koide, K. Uchinokura, M. C. Martin, M. Hase, K. Hirota and G. Shirane, Phys. Rev. B 54 (1996), R6835.
- [25] M. C. Martin, M. Hase, K. Hirota, G. Shirane, Y. Sasago, N. Koide and K. Uchinokura, Phys. Rev. B 56 (1997), 3173.
- [26] S. Coad, O. Petrenko, D. McK. Paul, B. Fåk, J-G. Lussier and D. F. McMorrow, Physica B 239 (1997) 350.
- [27] H. Fukuyama, T. Tanimoto and M. Saito, J. Phys. Soc. Jpn. 65, (1996) 1182.
- [28] K. M. Kojima, Y. Fudamoto, K. Larkin, G. M. Luke, J. Merrin, B. Nachumi, Y. J. Uemura, M. Hase, Y. Sasago, K. Uchinokura, Y. Ajiro, A. Revcolevschi, and J.-P. Renard, Phys. Rev. Lett. **79** (1997), 503.
- [29] K. Manabe, H. Ishimoto, N. Koide, Y. Sasago and K. Uchinokura, Phys. Rev. B 58 (1998), R575.
- [30] T. Masuda, A. Fujioka, Y. Uchiyama, I. Tsukada and K. Uchinokura, Phys. Rev. Lett. 80 (1998), 4566.
- [31] T. Masuda, I. Tsukada, K. Uchinokura, Y. Wang, V. Kiryukhin and R. Birgeneau, Phys. Rev. B 61 (2000), 4103.
- [32] H. Nakao, M. Nishi, Y. Fujii, K. Hirota, T. Masuda, K. Uchinokura and G. Shirane,
 物理学会概要集 53, Issue 1, Part 3 (1998) 472. また [33, 34] 参照.
- [33] H. Nakao, M. Nishi, Y. Fujii, T. Masuda, I. Tsukada, K. Uchinokura, K. Hirota and G. Shirane, J. Phys. Chem. Solids 60 (1999), 1117.
- [34] H. Nakao, M. Nishi, Y. Fujii, T. Masuda, I. Tsukada, K. Uchinokura, K. Hirota and G. Shirane, J. Phys. Soc. Jpn. 68 (1999), 3662.
- [35] M. Nishi, H. Nakao, Y. Fujii, T. Masuda, K. Uchinokura and G. Shirane, J. Phys. Soc. Jpn. (in press), cond-mat/0002429.
- [36] Y. J. Wang, V. Kiryukhin, R. Birgeneau, T. Masuda, I. Tsukada and K. Uchinokura, Phys. Rev. Lett. 83 (1999), 1676.
- [37] V. Kiryukhin, Y. J. Wang, S. C. LaMarra, R. Birgeneau, T. Masuda, I. Tsukada and K. Uchinokura, Phys. Rev. B 61 (2000), 9527.
- [38] J. Takeya, I. Tsukada, Y. Ando, T. Masuda and K. Uchinokura, Phys. Rev. B 61 (2000), 14700.

- [39] M. E. Fisher, Philos. Mag. 7 (1962), 1731.
- [40] V. Kiryukhin, B. Keimer, J. P. Hill, S. M. Coad, and D. McK. Paul, Phys. Rev. B 54 (1996), 7269.
- [41] T. Masuda, and K. Uchinokura, Physica B 284 (2000), 1637.
- [42] SrNi₂V₂O₈の秩序状態は、基本的には反強磁性相であるが、Dzyaloshinskii-Moriya(D-M)相互作用の存在のため、モーメントの canting が生じ、弱強磁性になっているものと思われる。
- [43] R. Wichmann and Hk. Müller-Buschbaum, Rev. Chim. Miner. 23 (1986), 1.
- [44] A. Zheludev, T. Masuda, I. Tsukada, Y. Uchiyama, K. Uchinokura, P. Böni and S.-H. Lee, Phys. Rev. B, 62 (2000), 8921.
- [45] 初期の chain mean-field 理論の代表的な論文としては以下のものがある [D. J. Scalapino, Y. Imry and P. Pincus, Phys. Rev. B 11 (1975), 2042.]。
- [46] T. Sakai and M. Takahashi, Phys. Rev. B 42 (1990), 4537.
- [47] R. M. Morra, W. J. L. Buyers, R. L. Armstrong, and K. Hirakawa, Phys. Rev. B 38 (1988), 543.
- [48] G. Xu, J. F. DiTusa, T. Ito, K. Oka, H. Takagi, C. Broholm and G. Aeppli, Phys. Rev. B 54 (1996), R6827.
- [49] L. P. Regnault, I. Zaliznyak, J. P. Renard and C. Vettier, Phys. Rev. B 50 (1994), 9174.
- [50] H. Mutka, C. Payen, P. Molinié, J. L. Soubeyroux, P. Colombet and A. D. Tayler, Phys. Rev. Lett. 67 (1991), 497.
- [51] I. Affleck, T. Kennedy, E. H. Lieb and H. Tasaki, Phys. Rev. Lett. 59 (1987), 799;
 Commun. Math. Phys. 115 (1988), 477.
- [52] S. Miyashita and S. Yamamoto, J. Phys. Soc. Jpn. 62 (1993), 1459.
- [53] M. Hagiwara, K. Katsumata, I. Affleck, B. I. Halperin and J. P. Renard, Phys. Rev. Lett. 65 (1990), 3181.
- [54] K. Uchinokura, Y. Uchiyama, T. Masuda, Y. Sasago, I. Tsukada, A. Zheludev, T. Hayashi, N. Miura and P. Böni, Physica B 284 (2000), 1641.